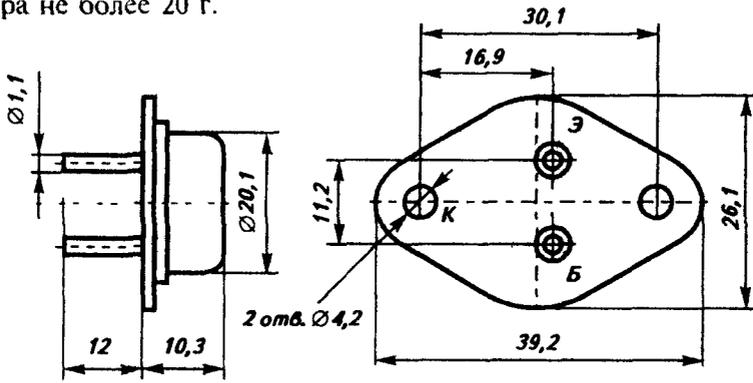


□ 2Т885А, 2Т885Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключа-
тельные. Предназначены для применения в источниках вторичного электропитания.
Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами.
Масса транзистора не более 20 г.



2Т885(А, Б)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5 \text{ В}$, $I_{к} = 20 \text{ А}$, $t_{и} = 100 \text{ мкс}$, $Q = 200$, не менее				
$T_{к} = +25^{\circ}\text{С}$				12
$T_{к} = +125 \text{ и } -60^{\circ}\text{С}$				8
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5 \text{ В}$, $I = 0,05 \text{ А}$				15 20* 25* МГц
Граничное напряжение при $I_{к} = 0,1 \text{ А}$, $L = 29 \text{ мГн}$				
2Т885А	400	450*	500* В	
2Т885Б	500	550*	600* В	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к} = 30 \text{ А}$, $I_{б} = 6 \text{ А}$, $t_{и} = 100 \text{ мкс}$, $Q = 200$				1,2* 2* 2,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к} = 30 \text{ А}$, $I_{б} = 6 \text{ А}$, $t_{и} = 100 \text{ мкс}$, $Q = 200$, не более				3,5 В
Время включения при $U_{кэ} = 200 \text{ В}$, $I_{к} = 30 \text{ А}$, $I_{к}/I_{б} = 5$	0,1*	0,15*	0,5* мкс	
Время рассасывания при $U_{кэ} = 200 \text{ В}$, $I_{к} = 30 \text{ А}$, $I_{б1} = 6 \text{ А}$, $I_{б2} = 9 \text{ А}$ не более				2 мкс
Время спада при $U_{кэ} = 200 \text{ В}$, $I_{к} = 30 \text{ А}$, $I_{б1} = 6 \text{ А}$, $I_{б2} = 9 \text{ А}$	0,25*	0,35*	0,5 мкс	
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 100 \text{ В}$	100*	150*	200* пФ	
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 5 \text{ В}$	3500*	3800*	4500* пФ	
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 500 \text{ В}$, не более				
$T_{к} = +25^{\circ}\text{С}$				1 мА
$T_{к} = +125 \text{ и } -60^{\circ}\text{С}$				2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 \text{ В}$ не более				50 мА

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор-база	800 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{эб} = -1,5 \text{ В}$ или $R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$	
2Т885А	400 В
2Т885Б	500 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{эб} = -1,5 \text{ В}$ или $R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$, $t_{и} = 20 \text{ мкс}$, $Q = 2$, $t_{ф} \geq 0,5 \text{ мкс}$	800 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	40 В
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 20 \text{ мкс}$, $Q = 10$	60 А
Постоянный ток базы	10 А
Импульсный ток базы при $t_{и} = 20 \text{ мкс}$, $Q = 10$	20 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_{к} = -60 \text{ } +25^{\circ}\text{С}$	150 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C
Тепловое сопротивление переход-корпус	0,84°C/Вт
Температура окружающей среды	-60°C $T_{к} = +125^{\circ}\text{С}$

¹ При $T_{к} = +25^{\circ}\text{С}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора, определится из выражения

$$P_{к, \text{ макс}} = (150 - T_{к}) / 0,84, \text{ Вт}$$